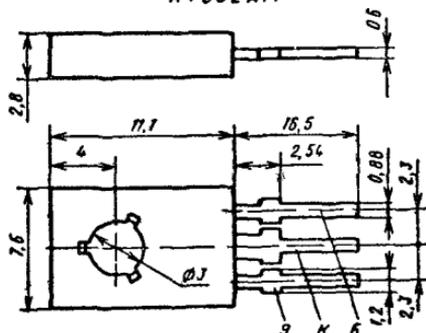


## КТ902АМ



### Электрические параметры

Выходная мощность на частоте $f = 10$ МГц при $U_{КЭ} = 28$ В, не менее	20 Вт
Коэффициент усиления по мощности на частоте $f = 10$ МГц при $P_{вых} = 10$ Вт, $U_{КЭ} = 28$ В, не менее	7
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_{К} = 2$ А, не менее	15
Модуль коэффициента передачи тока на частоте $f = 10$ МГц при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_{Б} = 1$ А, не менее	3,5
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{КЭ} = 2,5$ А, $I_{Б} = 0,4$ А, не более	2 В
Прямое напряжение база — эмиттер при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_{К} = 2$ А, не более	2 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 70$ В, не более	10 мА
Обратный импульсный ток коллектор — эмиттер при $U_{КБ} = 110$ В, $R_{бэ} = 50$ Ом, не более	60 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ББ} = 5$ В, не более	100 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база <sup>1</sup> при $T_n \leq +125^\circ\text{C}$	65 В
Импульсное напряжение коллектор — эмиттер <sup>1</sup> при $R_{бэ} \leq 50$ Ом, $t_u \leq 15$ мкс, $T_n \leq +125^\circ\text{C}$	110 В
Постоянное напряжение эмиттер — база <sup>1</sup> при $T_n \leq +125^\circ\text{C}$	5 В
Импульсное синусоидальное напряжение эмиттер — база при $t_u \leq 40$ мкс	8 В
Постоянный ток коллектора	5 А
Постоянный ток базы	2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>2</sup> при $T_n \leq +50^\circ\text{C}$	30 Вт
Тепловое сопротивление переход — корпус	3,3 $^\circ\text{C}/\text{Вт}$
Температура р-п перехода	+150 $^\circ\text{C}$
Температура корпуса	+125 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	-60 $^\circ\text{C}$ $T_n = +125^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_n > +125^\circ\text{C}$  напряжение снижается линейно до 0,5 от  $U_{КБ}$  выше при  $T_n = +150^\circ\text{C}$ .

<sup>2</sup> При  $T_n > +50^\circ\text{C}$   $P_{К, макс}$ , Вт =  $(150 - T_n)/3,3$

Изгибы и боковые натяжения выводов не допускаются. Запрещается кручение выводов вокруг оси.

Пайка выводов допускается на плоской части выводов транзисторов в течение времени не более 10 с. Температура припоя не должна превышать +250  $^\circ\text{C}$ . Между корпусом транзистора и местом пайки необходимо осуществлять теплоотвод.

Транзисторы кремниевые мезаэпитарные структуры *npn* генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности КВ диапазона при напряжении питания 28 В. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2,5 г.